BD241BFP
BD242BFP

COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS

- STMicroelectronics PREFERRED SALESTYPES
- COMPLEMENTARY PNP - NPN DEVICES
- FULLY MOLDED ISOLATED PACKAGE
- 2000 V DC ISOLATION (U.L. COMPLIANT)

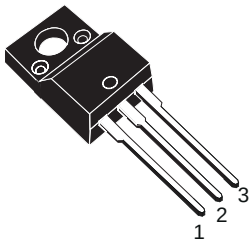
APPLICATIONS
- GENERAL PURPOSE SWITCHING
- GENERAL PURPOSE AMPLIFIERS

DESCRIPTION

The BD241BFP is silicon epitaxial-base NPN transistors mounted in TO-220FP fully molded isolated package.

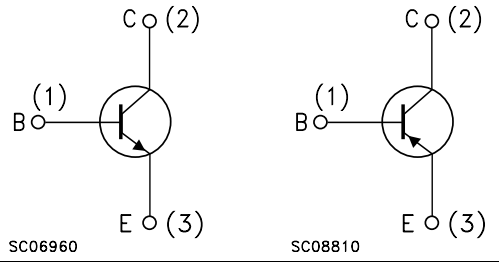
It is inteded for power linear and switching applications.

The complementary PNP types is the BD242BFP.



TO-220FP

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter		Value	Unit
		NPN	BD241BFP	
		PNP	BD242BFP	
V_{CER}	Collector-Base Voltage (R_{BE} = 100 Ω)		90	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage (I_B = 0)		80	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage (I_C = 0)		5	V
I_C	Collector Current		3	A
I_{CM}	Collector Peak Current		5	A
I_B	Base Current		1	A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_c \leq 25\ ^oC$		24	W
T_{stg}	Storage Temperature		-65 to 150	^oC
T_j	Max. Operating Junction Temperature		150	^oC

For PNP types voltage and current values are negative.

THERMAL DATA

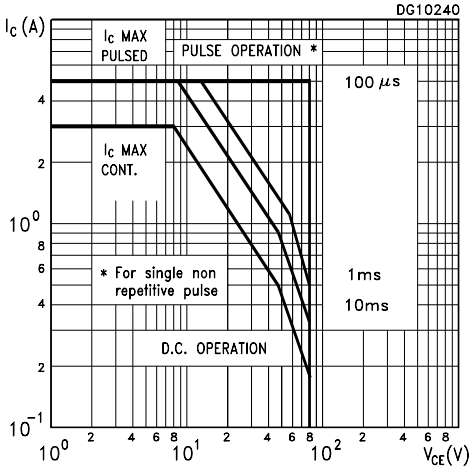
$R_{thj\text{-}case}$	Thermal Resistance Junction-case	Max	5.3	$^oC/W$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25 ^oC unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CEO}	Collector Cut-off Current (I_B = 0)	V_{CE} = 60 V			0.3	mA
I_{CES}	Collector Cut-off Current (V_{BE} = 0)	V_{CE} = 80 V			0.2	mA
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current (I_C = 0)	V_{EB} = 5 V			1	mA
$V_{CEO(sus)}$*	Collector-Emitter Sustaining Voltage (I_B = 0)	I_C = 30 mA	80			V
$V_{CE(sat)}$*	Collector-Emitter Saturation Voltage	I_C = 3 A I_B = 0.6 A			1.2	V
$V_{BE(ON)}$*	Base-Emitter Voltage	I_C = 3 A V_{CE} = 4 V			1.8	V
h_{FE}*	DC Current Gain	I_C = 1 A V_{CE} = 4 V I_C = 3 A V_{CE} = 4 V	25 10			

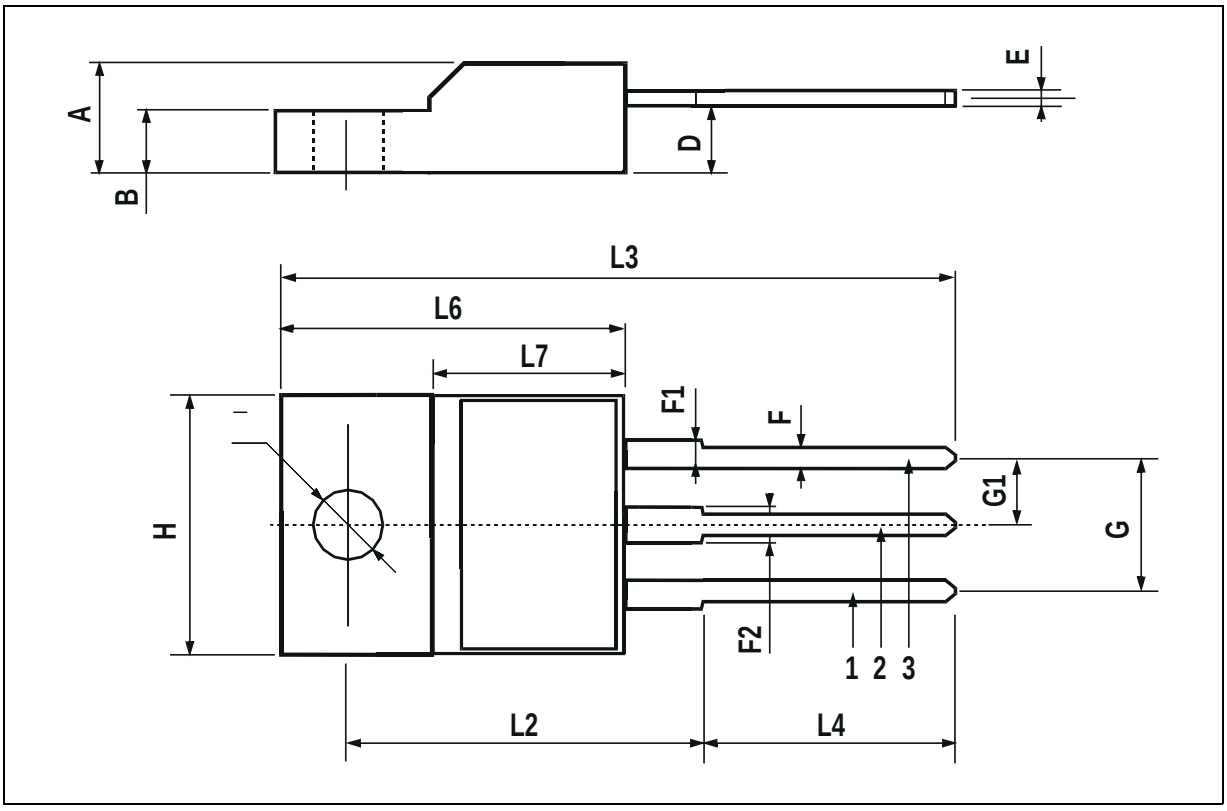
* Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle ≤ 2 %
For PNP types voltage and current values are negative.

Safe Operating Area



TO-220FP MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.4		4.6	0.173		0.181
B	2.5		2.7	0.098		0.106
D	2.5		2.75	0.098		0.108
E	0.45		0.7	0.017		0.027
F	0.75		1	0.030		0.039
F1	1.15		1.7	0.045		0.067
F2	1.15		1.7	0.045		0.067
G	4.95		5.2	0.195		0.204
G1	2.4		2.7	0.094		0.106
H	10		10.4	0.393		0.409
L2		16			0.630	
L3	28.6		30.6	1.126		1.204
L4	9.8		10.6	0.385		0.417
L6	15.9		16.4	0.626		0.645
L7	9		9.3	0.354		0.366
Ø	3		3.2	0.118		0.126



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 2001 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

http://www.st.com

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9